

5551

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 " )

■用途:

\*放大器

\*通信产品中的高压开关线路

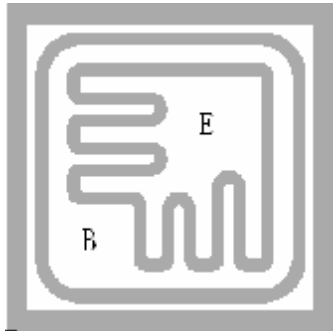
■特征:

\*与 5401 配对

\*集电极电流:0.6A

\*有效管芯数(只):33400

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	460 μ m×460 μ m
压焊区尺寸	基 区 117 μ m×117 μ m 发射区 130 μ m×130 μ m
芯片厚度	220±10 μ m
锯片槽尺寸	56μm
金属层	正面:Al 1.85±0.15μm 背面:Au 1.1±0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最 小	最 大	单 位
集电极--基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =100 μ A,I <sub>E</sub> =0	180		V
集电极--发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =1mA,I <sub>B</sub> =0	160		V
发射极--基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =100 μ A,I <sub>C</sub> =0	6		V
集电极--基极截止电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =120V,I <sub>E</sub> =0		200	nA
发射极--基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =4V,I <sub>C</sub> =0		200	nA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5V,I <sub>C</sub> =10mA	80	400	
集电极--发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =50mA, I <sub>B</sub> =5mA		0.2	V